

半 导 体 学 报

第 10 卷 第 7 期 1989 年 7 月

目 录

- RF 溅射碳化硅薄膜的结构研究 王英华 汤海鹏 田民波 李恒德 (483)
- NMOS 短沟 DD 结构热载流子效应的研究 杨肇敏 徐葭生 (489)
- 射频溅射 CoMnNi 氧化物薄膜结构研究
..... 谭 辉 陶明德 韩 英 张 寒 (497)
- 空心阴极离子淀积 TiN 薄膜特性研究
..... 高玉芝 夏宗璜 武国英 张利春 黄济群 张德贤 (503)
- PMMA 的离子束曝光特性 王宇钢 赵渭江 郑桂洲 高玉芝 (509)
- 注入氧形成的 SOI 结构中氧分布的模拟 阮 刚 徐晨曦 俞 强 (514)
- 离子束增强沉积制备氮化硅薄膜的计算机模拟
..... 周建坤 陈西善 柳襄怀 杨根庆 邹世昌 (519)

研 究 简 报

- 一种制作亚微米间隔的方法 谢可勋 蒋建飞 谢 纓 (525)
- 窄禁带半磁半导体 $Hg_{1-x}Mn_xTe$ 的磁化强度
..... 陈辰嘉 王学忠 刘继周 R. R. Gałazka (529)
- 用 Raman 光谱研究掺氧多晶硅的微结构 王云珍 潘尧令 (534)
- 非均匀掺杂衬底 MOS 结构少子产生寿命的测量
..... 黄庆安 史保华 顾 英 张德胜 (538)
- SI GaAs 中 S^+ 注入的电学特性 夏冠群 关安民 耿海阳 王渭源 (542)
- 短沟道 MOS FET 亚阈值电流的解析模型
..... 陈登元 汤庭鳌 C. A. Paz de Araujo (547)
- GaAsP 混晶中 Fe 杂质能级的无序分裂 黄启圣 (553)
- Si/GaP(111) 和 (111) 界面的研究 黄春晖 (556)
- 硅中氢分子和空位型缺陷间的相互作用 施天生 白国仁 (561)